



Maßbild mit Anschlußbelegung

Gehäuse: SOT-89

Silizium-PNP-Planar-Darlington-Transistoren für Anwendungen in der Hybrid- und Auf-
setztechnik

Grenzwerte

Grenzwert	Kurz- zeichen	min.	max.	Einheit
Kollektor-Basis-Spannung	$-U_{CBO}$		60 ¹⁾ 80 ²⁾ 90 ³⁾	V V V
Kollektor-Emitter-Spannung	$-U_{CER}$		45 ¹⁾ 60 ²⁾ 80 ³⁾	V V V
Emitter-Basis-Spannung	$-U_{EBO}$		5	V
Kollektorstrom	$-I_C$		0,5	A
Kollektorspitzenstrom	$-I_{CM}$		1,5	A
Basisstrom	$-I_B$		100	mA
Gesamtverlustleistung bei $T_{amb} \leq 25 \text{ °C}$ - auf Keramiksubstrat 0,7 mm dick 2,5 cm ² Fläche	P_{tot}		1	W
Sperrschichttemperatur	T_j		150	°C
Betriebstemperaturbereich	T_{stg}	-55	125	°C

1) SSE 560; 2) SSE 561; 3) SSE 562

Grenzwerte

Grenzwert	Kurzzeichen	min.	max.	Einheit
Wärmewiderstände zwischen Sperrschicht und Umgebung				
- auf Keramiksubstrat 0,7 mm dick 2,5 cm ² Fläche	R_{thja}		125	K/W
zwischen Sperrschicht und Kollektor	R_{thjc}		10	K/W

Ausgewählte Kennwerte ($T_{amb} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$)

Kennwert	Kurzzeichen	Meßbedingung	min.	typ.	max.	Einheit
Kollektor-Emitter- Reststrom	$-I_{CES}$	$U_{BE} = 0$ $-U_{CE} = -U_{CERmax}$			10	μA
Emitter-Reststrom	$-I_{EBO}$	$I_C = 0$ $-U_{EB} = 4 \text{ V}$			10	μA
Kollektor-Emitter- Restspannung	$-U_{CESat}$	$-I_C = 0,5 \text{ A}$ $-I_B = 0,5 \text{ mA}$			1,3	V
Basisspannung	$-U_{BESat}$	$-I_C = 0,5 \text{ A}$ $-I_B = 0,5 \text{ mA}$			1,9	V
Gleichstromverstärkung	h_{FE}	$-U_{CE} = 10 \text{ V}$ $-I_C = 0,15 \text{ A}$	1000			
	h_{FE}	$-I_C = 0,5 \text{ A}$	2000			
Schaltzeiten	t_{ein}	$-I_{CX} = 0,5 \text{ A}$ $-I_{BX} = 0,5 \text{ mA}$		0,4		μs
	t_{aus}	$-I_{CX} = 0,5 \text{ A}$ $-I_{BX} = 0,5 \text{ mA}$		1,5		μs